

	<p>NAME: Khalilloev Mahkham Muxammadsharifovich</p> <p>POSITION: Lecturer</p> <p>TEL: +99893 741 48 66</p> <p>E – mail: x-mahkam@mail.ru</p> <p>ORGANISATION TEL: +99862 2246700</p> <p>ORGANISATION ADRESS: Urgench, Kh.Olimjan str, 14, 220100</p>
EDUCATION:	<ul style="list-style-type: none"> • 2008 – 2012 - Urgench State University (bachelor) • National University of Uzbekistan (master) in 2012-2014
CAREER / EMPLOYMENT:	<ul style="list-style-type: none"> • 2014 - 2017 Lecturer, Department of Physics, Urgench State University • 2018 - 2020 PhD student, Urgench State University • 2021 - So far, a Senior Lecturer at the Department of Physics, Urgench State University
SPECIALITY	<ul style="list-style-type: none"> • Heliophysics and the use of solar energy.
TEACHING SUBJECTS:	<ul style="list-style-type: none"> • General Physics, Atom physics, radiophysics,
RESEARCH AREAS OF INTEREST:	<ul style="list-style-type: none"> • Modeling the effect of technological fluctuations on the characteristics of junctionless transition nanoscale field-effect transistors
PRESENT PROJECTS:	<ul style="list-style-type: none"> • A. E. Atamuratov, M.M Khalilloev, A. Abdikarimov, Z. A. Atamuratova, M. Kittler, R. Granzner, F. Schwierz Simulation of DIBL effect in junctionless SOI MOSFETs with extended gate//NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 2017, 8 (1), P. 75–78 DOI 10.17586/222080542017817578 • A Atamuratov, M.M Khalilloev, A Yusupov Simulation of DIBL effect and sub-threshold swing in low power junctionless MOSFETs with different geometries //International Journal of Applied Science – Research and Review, 2018, Volume: 5 DOI: 10.21767/2394-9988-C1-003 • M.M Khalilloev, B. O. Jabbarova A. A. Nasirov The Influence of Fin Shape on the Amplitude of Random Telegraph Noise in the Subthreshold Regime of a Junctionless FinFET //Technical Physics Letters, 2019, Vol. 45, No. 12, pp. 1245–1248. • A. E. Atamuratov, M.M Khalilloev, A. Yusupov, A. J. Garcia-Loureiro, Jean Chamberlain Chedjou, Kyamakya Kyandoghene Contribution to the Physical Modelling of Single Charged Defects Causing the Random Telegraph Noise in Junctionless FinFET//Appl. Sci. 2020, 10, 5327; doi:10.3390/app10155327 • Халиллоев М.М., Атамуратов А.Э. Зависимость DIBL эффекта от формы канального слоя в безпереходном МОП- транзисторе//Яримўтказгичлар

	<p>физикасининг ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришнинг замонавий муаммолари мавзусида Республика илмий-амалий анжумани.- Андижон. 20-21 апрель, 2018. - б.91-93.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Халиллоев М.М., А.Э. Абдикаримов, З. Атамуратова, Б. Жаббарова, А.Э. Атамуратов. Короткоканальные эффекты в безпереходном МОП-транзисторе с различным уровнем легирования и формой базы//Республиканской научно-практической конференции участием зарубежных ученых «Инновационные технологии в науке и образовании». - Нукус. 20-21 ноября, 2018. - С. 106-107. • Халиллоев М.М., Атамуратов А.Э. Влияние формы канального слоя в безпереходном МОП-транзисторе на крутизну подпороговой переходной характеристики Мухаммад ал-Хоразмий издошлари мавзусидаги Республика илмий-техникавий анжумани - Урганч. 27-28 апрель, 2018. - б.68-69 • Халиллоев М.М., Атамуратов А.Э. Зависимость крутизны передаточной характеристики от боковых линейных размеров затвора и скрытого оксидного слоя в беспереходном МОП-транзисторе Физика фанининг ривожиди истеъдодли ёшларнинг ўрни РИАК-ХИ-2018 – Тошкент. 11-12 май, 2018 - б.25-26 • Халиллоев М.М., Жаббарова Б.О., Атамуратов А.Э. Влияние формы канального слоя и бокового расширения затвора на пороговое напряжение в безпереходном МОП-транзисторе //Материалы международной конференции «Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниковых микро- и наноструктурах». - Фергана. 25-26 мая, 2018.- С. 295-296 • Халиллоев М.М., Жаббарова Б.О., Атамуратов А.Э. Сравнение амплитуды случайных телеграфных шумов в МОП транзисторах без переходов и с инверсионным каналом//«Современные проблемы физики полупроводников» СПФП-2019 –Нукус 20 ноября 2019 г. 82-86
<p>LIST OF SELECTED PAPERS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atabek E. Atamuratov, Mahkam M. Khalilloev, Ahmed Yusupov, Jean Chamberlain Chedjou, Kyandoghere Kyamakya Amplitude of Random Telegraph Noise in Junctionless FinFET with Different Channel Shape// e-Journal of Surface Science and Nanotechnology 19, 9–12 (2021) • A.E.Atamuratov, B.O. Jabbarova, M.M. Khalilloev, A. Yusupov, A.G.J.Loureiro Self-heating effect in nanoscale SOI Junctionless FinFET with different geometries// 13th Spanish Conference on Electron Devices • Atabek E. Atamuratov, Mahkam M. Khalilloev, Ahmed Yusupov, A. J. Garcia-Loureiro, Jean Chamberlain Chedjou and Kyamakya Kyandoghere Contribution to the Physical Modelling of Single Charged Defects Causing the Random Telegraph Noise in Junctionless FinFET// <i>Appl. Sci.</i> 2020, <i>10</i>, 5327; doi:10.3390/app10155327.